



2023年11月27日

各 位

会 社 名 株式会社フルヤ金属  
代 表 者 名 代表取締役社長 古 屋 堯 民  
(コード番号: 7826)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 榊 田 裕 之  
電 話 03-5977-3377

### 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2023年11月16日開催の取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行価格（募集価格）	1株につき	金 9,139 円
(2) 発行価格の総額		9,541,116,000 円
(3) 払込金額	1株につき	金 8,710.60 円
(4) 払込金額の総額		9,093,866,400 円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	4,546,933,200 円
	増加する資本準備金の額	4,546,933,200 円
(6) 申込期間	2023年11月28日（火）～ 2023年11月29日（水）	
(7) 払込期日	2023年12月5日（火）	

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

#### 2. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出株式数		156,000 株
(2) 売出価格	1株につき	金 9,139 円
(3) 売出価格の総額		1,425,684,000 円
(4) 申込期間	2023年11月28日（火）～ 2023年11月29日（水）	
(5) 受渡期日	2023年12月6日（水）	

ご注意: この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

### 3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	金 8,710.60 円
(2) 払込金額の総額	(上限)	1,358,853,600 円
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 増加する資本準備金の額	(上限) 679,426,800 円 (上限) 679,426,800 円
(4) 申込期間 (申込期日)		2023 年 12 月 25 日 (月)
(5) 払込期日		2023 年 12 月 26 日 (火)

#### <ご参考>

##### 1. 発行価格 (募集価格) 及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2023 年 11 月 27 日 (月)	9,520 円
(2) ディスカウント率		4.00%

##### 2. シンジケートカバー取引期間

2023 年 11 月 30 日 (木) から 2023 年 12 月 20 日 (水) までの間

##### 3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 10,393,720,000 円については、1,800,000,000 円を 2025 年 6 月末までに土浦工場における水電解装置向け触媒 (※1) 量産設備の増設及び土浦工場の稼働率向上に資する工場構内設備に係る設備投資資金に、3,700,000,000 円を 2026 年 6 月末までに千歳工場における半導体装置向け熱電対 (※2) 量産設備の増設及びそれに伴う工場構内設備に係る設備投資資金に、3,500,000,000 円を 2026 年 6 月末までにつくば工場におけるターゲット (※3) 等の当社薄膜事業の主要製品量産設備の増設及びそれに伴う工場構内設備、当社電子事業におけるパワー半導体向け GaN 結晶育成用貴金属大型ライナー (※4) の製造強化に資する工場構内設備並びに当社サーマル事業におけるリフレクター量産設備の設置に係る設備投資資金に、残額を 2025 年 6 月末までに上記設備投資による増産に伴う生産工程に必要なプラチナグループメタル (イリジウム・ルテニウム等) の調達資金に充当する予定であります。

上記手取金は、具体的な充当期までは当社預金口座にて適切に管理いたします。

- ※1 純水から水素を製造する PEM (Polymer Electrolyte Membrane: 固体高分子電解質膜) 法の電極材料として使われる貴金属材料です。
- ※2 半導体の酸化工程における拡散炉の精密な温度制御用に使用される温度測定用製品です。
- ※3 ハードディスクドライブ等の電子部品、磁気記録媒体及びディスプレイの薄膜形成に使用される高純度ないし合金の貴金属板材です。
- ※4 GaN (窒化ガリウム) は高耐圧性を活かしてパワー半導体での利用が期待されていますが、GaN 結晶を育成する製造設備のライニング (内張り) 材として、当社ライナー製品が利用されております。

当社グループの設備投資計画の内容につきましては、2023 年 11 月 16 日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意: この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分 (作成された場合) をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。